

【注意】途中の計算を必ず書こう。結果だけの解答は採点出来ない。A4 手書メモ 1 枚持込可。

1. 長さ L の細線に閉じ込められた電子の状態密度が $\frac{L\sqrt{2m}}{\pi\hbar} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ となることを示そう。

【略解】分散関係 $\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ より、 $d\varepsilon = \frac{\hbar^2 k}{m} dk$

状態密度は、電子の運動方向(左・右)とスピンを考慮して、

$$2 \cdot L \cdot \frac{2dk}{2\pi} = \frac{2L dk}{\pi} \quad d\varepsilon = \frac{2L}{\pi} \frac{m}{\hbar^2 k} d\varepsilon = \frac{2Lm}{\pi \hbar^2} \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}}} = \frac{L\sqrt{2m}}{\pi \hbar \sqrt{\varepsilon}} d\varepsilon$$

2. 続いてフェルミエネルギー ε_F 及びフェルミ波数 k_F を求めよう。

【略解】絶対零度では $N = \int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{L\sqrt{2m}}{\pi\hbar} \int_0^{\varepsilon_F} \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{L\sqrt{2m}}{\pi\hbar} 2\sqrt{\varepsilon_F}$

よって、 $\varepsilon_F = \left(\frac{\pi\hbar}{2\sqrt{2m}} \frac{N}{L} \right)^2$ さらに、 $\frac{\hbar k_F}{\sqrt{2m}} = \frac{\pi\hbar}{2\sqrt{2m}} \frac{N}{L}$, $\therefore k_F = \frac{\pi N}{2L}$ ~ 粒子間隔の逆数程度

※粒子数 N を書き忘れていたので板書で追加しました。

3. 続いて化学ポテンシャル μ の低温での温度依存性を求めよう。

ヒント—Sommerfeld の公式 $\int_0^{+\infty} f(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon = G(\mu) + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 G''(\mu) + \dots$ を使い、

さらに $\mu = \varepsilon_F + \Delta\mu$ とおいて $\Delta\mu$ は非常に小さいとして展開してみよう。

【略解】粒子数保存の式より、 $N = \int_0^{\infty} D(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon$ に対して、 $g \equiv D$, $G = \int_0^{\mu} D d\varepsilon$ とおけば、

$$\therefore N \approx G(\mu) + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 D'(\mu)$$

となるから、 $\mu = \varepsilon_F + \Delta\mu$ を代入すると、

$$= G(\varepsilon_F + \Delta\mu) + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 D'(\varepsilon_F + \Delta\mu) = \underbrace{G(\varepsilon_F)}_N + \underbrace{G'(\varepsilon_F)}_{D(\varepsilon_F)} \Delta\mu + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 (D'(\varepsilon_F) + D''(\varepsilon_F)\Delta\mu)$$

ここで、 $N = G(\epsilon_F)$ 及び、上式の最後の項は温度の高次のべきになることに注意して、

$$= N + D(\epsilon_F)\Delta\mu + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 D'(\epsilon_F) + O(T^3)$$

$$\therefore \Delta\mu = -\frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 \frac{D'(\epsilon_F)}{D(\epsilon_F)}$$

ここで、一次元では先ほど求めたように $D(\epsilon) = \frac{B}{\sqrt{\epsilon}}$ なのであるから、 $D'(\epsilon) = -\frac{B}{2\epsilon^{3/2}}$

$$\therefore \mu = \epsilon_F + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 \frac{B}{2\epsilon_F^{3/2}} \bigg/ \frac{B}{\sqrt{\epsilon_F}} = \epsilon_F + \frac{\pi^2(k_B T)^2}{12\epsilon_F}$$

一次元では、化学ポテンシャルは温度を上げると増えるのだ。理由は、高エネルギーの方が状態密度が小さいため、入りにくくなるからである。

4. 面積 A の平面に閉じ込められた光子のエネルギー密度 $u(\epsilon) = D(\epsilon)f_B(\epsilon)$ を求めよう。

【略解】分散関係は $\epsilon = \hbar ck$ であるから、微分は $d\epsilon = \hbar c dk$ であり、さらに、

偏波方向によるモード数 2 に気をつけて、

$$2A \cdot \frac{d^2k}{(2\pi)^2} = 2A \cdot \frac{2\pi k dk}{(2\pi)^2} = \frac{A k dk}{\pi} = \frac{A k}{\pi} \frac{dk}{d\epsilon} d\epsilon = \frac{k}{\pi \hbar c} A d\epsilon = \frac{\epsilon/\hbar c}{\pi \hbar c} A d\epsilon = \frac{A\epsilon}{\pi(\hbar c)^2} d\epsilon$$

光子の化学ポテンシャルはゼロなのでエネルギー密度は、 $u(\epsilon, T) = \frac{A\epsilon}{\pi(\hbar c)^2} \frac{1}{e^{\epsilon\beta} - 1}$

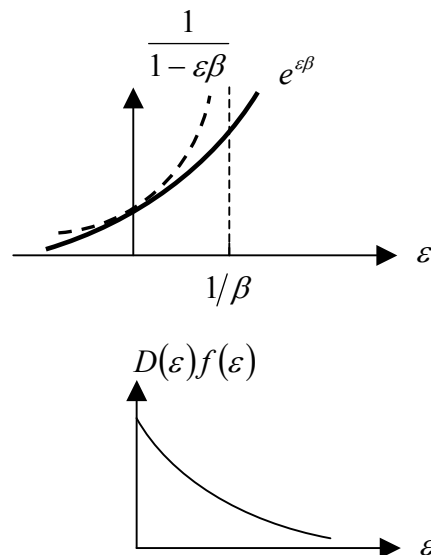
※エネルギー密度と言いながら、 ϵ が書いていませんでしたので、 $u(\epsilon) = D(\epsilon)f_B(\epsilon)$ を

計算した人も $\epsilon D(\epsilon)f_B(\epsilon)$ を計算した人もどちらも正解にし

ます。

5. 上問で、 $\epsilon \rightarrow 0$ 及び $\epsilon \rightarrow \infty$ にした場合の極限ではどのような関数に漸近するか？

ヒント— $u(\epsilon)$ の ϵ 依存性を、 $u(0) \sim \text{定数}$ 、 $u(\infty) \sim 0$ より、もう少し詳しく求めよ。



【略解】 $\varepsilon \rightarrow 0$ で $u \propto \frac{\varepsilon}{\varepsilon\beta + (\varepsilon\beta)^2} \propto \frac{1}{1 + \varepsilon\beta}$ 、 $\varepsilon \rightarrow \infty$ で $u \propto \frac{1}{e^{\varepsilon\beta}}$

6. $u(\varepsilon)$ をグラフにして見よう。極値があるかどうかには注意しよう。

【略解】 $\frac{\partial u}{\partial \varepsilon} \sim e^{\varepsilon\beta} - 1 - \varepsilon\beta e^{\varepsilon\beta} = 0$ より、極値となる条件は $e^{\varepsilon\beta} = \frac{1}{1 - \varepsilon\beta}$

両辺をグラフにすると、右上図のように、 $\varepsilon = 0$ でのみ成立しそう。

しかし、 $\varepsilon = 0$ では分母もゼロになるので、結局 $\frac{\partial u}{\partial \varepsilon}(0) \neq 0$ である。

よって、右下図のように、 $\varepsilon = 0$ から有限の勾配で単調減少する。

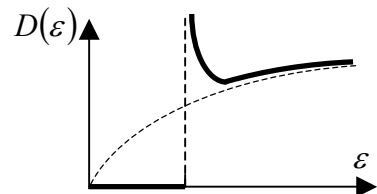
7. 電子が通常 $\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ ではなく、 $\varepsilon = \sqrt{\Delta^2 + \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m}\right)^2}$ という分散関係を持つとしよう。

ここで Δ は正の定数、 m は電子の質量であり、電子は三次元空間を運動するものとする。

単位体積あたりの状態密度を求め、 $\varepsilon > \Delta$ の範囲でグラフに描いてみよう。

【略解】 $d\varepsilon = d\sqrt{\Delta^2 + \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m}\right)^2} = \frac{1}{2\varepsilon} d\left(\frac{\hbar^4 k^4}{4m^2}\right) = \frac{\hbar^4}{2m^2} \frac{k^3 dk}{\varepsilon}$ より、 $\frac{dk}{d\varepsilon} = \frac{2m^2 \varepsilon}{\hbar^4 k^3}$

$$\begin{aligned} \therefore (2S+1) \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} &= 2 \cdot \frac{4\pi k^2}{8\pi^3} \frac{dk}{d\varepsilon} d\varepsilon = \frac{k^2}{\pi^2} \frac{2m^2 \varepsilon}{\hbar^4 k^3} d\varepsilon = \frac{1}{\pi^2} \frac{2m^2 \varepsilon}{\hbar^4 k} d\varepsilon = \frac{2m^2 \varepsilon}{\pi^2 \hbar^4} \frac{1}{\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} \sqrt{\varepsilon^2 - \Delta^2}}} d\varepsilon \\ &= \frac{\sqrt{2m^3}}{\pi^2 \hbar^3} \frac{\varepsilon d\varepsilon}{(\varepsilon^2 - \Delta^2)^{1/4}} \end{aligned}$$



8. 上問で、 $\varepsilon \rightarrow \infty$ の領域では状態密度はどのような関数形に漸近するか？ Δ

【略解】上問の結果より直ちに、 $D(\varepsilon \rightarrow \infty) \approx \frac{\sqrt{2m^3 \varepsilon}}{\pi^2 \hbar^3}$ であり、通常の三次元金属の状態密度である。

落ち着いて考えれば、 $\varepsilon \rightarrow \infty$ では分散の式は、

$$\varepsilon \approx \sqrt{\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m}\right)^2} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

であり、自由電子の分散と一致しているのだ。

※お察しの通り、超伝導状態の電子にヒントを得て作題しましたが、超伝導の準粒子は、フェルミエネルギーをエネルギーの原点 $\varepsilon = 0$ にとり、 ε の範囲は正負両側です。